

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120808000B
2012年10月2日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎

HPA/PWR SOIC パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更のご案内

(既報 1127 製品からの対象除外 38 製品及び一部製品ワイヤ径変更の連絡)

(第二版 PCN20120808000A 2012年9月7日発行, 初版 PCN20120808000 2012年8月24日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

日本テキサス・インストルメンツ株式会社

SN65LVDS34DR	THS4131CDRG4	TLC3541IDG4	TLV2454AIDG4	TPS71025DG4
SN65LVDS34DRG4	THS4131ID	TLC3541IDR	TLV2454AIDR	TPS71025DR
SN65LVDS391D	THS4131IDG4	TLC3541IDRG4	TLV2454AIDRG4	TPS71025DRG4
SN65LVDS391DG4	THS4131IDR	TLC3545ID	TLV2454CD	TPS7133QD
SN65LVDS391DR	THS4131IDRG4	TLC3545IDG4	TLV2454CDG4	TPS7133QDG4
SN65LVDS391DRG4	THS4150CD	TLC3545IDR	TLV2465CD	TPS7133QDR
SN65LVDS9637BD	THS4150CDG4	TLC3545IDRG4	TLV2465CDG4	TPS7133QDRG4
SN65LVDS9637BDG4	THS4150CDR	TLC3702CD	TLV2465CDR	TPS7148QD
SN65LVDS9637BDR	THS4150CDRG4	TLC3702CDG4	TLV2465CDRG4	TPS7148QDG4
SN65LVDS9637BDRG4	THS4215D	TLC3702CDR	TLV2475AIDR	TPS7148QDR
SN65LVDS9637D	THS4215DG4	TLC3702CDRG4	TLV2475AIDRG4	TPS7148QDRG4
SN65LVDS9637DG4	THS4215DR	TLC372CD	TLV2541ID	TPS7201QD
SN65LVDS9637DR	THS4215DRG4	TLC372CDG4	TLV2541IDG4	TPS7201QDG4
SN65LVDS9637DRG4	THS4221D	TLC372CDR	TLV2541IDR	TPS7201QDR
SN65LVDS9638D	THS4221DG4	TLC372CDRG4	TLV2541IDRG4	TPS7201QDRG4
SN65LVDS9638DG4	THS4222D	TLC372ID	TLV2544CD	TPS7233QD
SN65LVDS9638DR	THS4222DG4	TLC372IDG4	TLV2544CDG4	TPS7233QDG4
SN65LVDS9638DRG4	THS4222DR	TLC372IDR	TLV2544CDR	TPS7233QDR
SN65LVDT100D	THS4222DRG4	TLC372IDRG4	TLV2544CDRG4	TPS7233QDRG4
SN65LVDT100DG4	THS4271D	TLC374ID	TLV2772AID	TPS7301QD
SN65LVDT100DR	THS4271DG4	TLC374IDG4	TLV2772AIDG4	TPS7301QDG4
SN65LVDT100DRG4	THS4271DR	TLC374IDR	TLV2772AIDR	TPS7301QDR
SN65LVDT32BD	THS4271DRG4	TLC374IDRG4	TLV2772AIDRG4	TPS7301QDRG4
SN65LVDT32BDG4	THS4281D	TLC393ID	TLV2772CD	TPS7330QD
SN65LVDT32BDR	THS4281DG4	TLC393IDG4	TLV2772CDG4	TPS7330QDG4
SN65LVDT32BDRG4	THS4281DR	TLC393IDR	TLV2772CDR	TPS7330QDR
SN65LVDT33D	THS4281DRG4	TLC393IDRG4	TLV2772CDRG4	TPS7330QDRG4
SN65LVDT33DG4	THS4304D	TLC4501AID	TLV2772ID	TPS7333QD
SN65LVDT33DR	THS4304DG4	TLC4501AIDG4	TLV2772IDG4	TPS7333QDG4
SN65LVDT33DRG4	THS4304DR	TLC4501AIDR	TLV2772IDR	TPS7333QDR
SN65LVDT3486BD	THS4304DRG4	TLC4501AIDRG4	TLV2772IDRG4	TPS7333QDRG4
SN65LVDT3486BDG4	THS4501CD	TLC4502ACD	TLV2774CD	TPS7350QD
SN65LVDT3486BDR	THS4501CDG4	TLC4502ACDG4	TLV2774CDG4	TPS7350QDG4
SN65LVDT34D	THS4502CD	TLC4502ACDR	TLV2774CDR	TPS7350QDR
SN65LVDT34DG4	THS4502CDG4	TLC4502ACDRG4	TLV2774CDRG4	TPS7350QDRG4
SN65LVDT34DR	THS4502ID	TLC4502AID	TLV5604CD	TPS7418D
SN65LVDT34DRG4	THS4502IDG4	TLC4502AIDG4	TLV5604CDG4	TPS7418DG4
SN65LVDT390D	THS4502IDR	TLC4502AIDR	TLV5604CDR	TPS7433D
SN65LVDT390DG4	THS4502IDRG4	TLC4502AIDRG4	TLV5604CDRG4	TPS7433DG4
SN65MLVD047AD	THS4503ID	TLC4502CD	TLV5604ID	TPS7433DR
SN65MLVD047ADG4	THS4503IDG4	TLC4502CDG4	TLV5604IDG4	TPS7433DRG4
SN65MLVD047ADR	THS4503IDR	TLC4502CDR	TLV5606CD	
SN65MLVD047ADRG4	THS4503IDRG4	TLC4502CDRG4	TLV5606CDG4	
SN65MLVD047D	THS4504D	TLC4545ID	TLV5606CDR	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年8月	終了	2012年11月
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	CDCVF25081DR	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	-	30	-	-
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-

信頼性試験期間	開始	2012年8月	終了	2012年11月
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	SN65HVD1050DR	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77		
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77		
Manufacturability	per mfg. Site specification		per spec	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12		

信頼性試験期間	開始	2012年8月	終了	2012年11月
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	TB3R2DR	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12	-	-

Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年8月	終了	2012年11月
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	RC4558DR	-	-	-
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4211470	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	-
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs	77	-	-
Electrical Characterization	-	30	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	-	-
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Flammability	Method A - UL94-0	5	-	-
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	5	-	-
Flammability	Method C - UL 1694	5	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年8月	終了	2012年11月
信頼性試験 – 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74LV14ADR	-	-	-
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/14	
Mount Compound:	4211470	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	-
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs	77	-	-
Electrical Characterization	-	30	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	-	-
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Flammability	Method A - UL94-0	5	-	-
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	5	-	-
Flammability	Method C - UL 1694	5	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012年8月	終了	2012年11月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ULN2003ADR	-	-	-
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4211470	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	-

信頼性試験計画

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs	77
Electrical Characterization	-	30
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec

Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年10月17日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CD4053BM96	-	-	-
Assembly Site:	TI Mexico	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	-

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails
Steady-state Life Test	150C, 300 Hrs	77/0
Electrical Characterization	-	Approved
**High Temp. Storage Bake	170C, 600 Hrs	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 192 Hrs	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0
Visual / Mechanical	-	Approved
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units	22/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0
X-ray	Top-side only	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0

Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年10月17日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ULN2003ADR	-	-	-
Assembly Site:	TI Mexico	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 300 Hrs	77/0	-	-
Electrical Characterization	-	Approved	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 600 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 192 Hrs	77/0	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Visual / Mechanical	-	Approved	-	-
Lead Pull	-	22/0	22/0	22/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	-	-
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
X-ray	Top-side only	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0	12/0	12/0

Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C